		Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.					
			Конденсаторы		
		C1	10мкФ X5R 10% 10В 0805, GRM21BR61 Электролитический	1	
		C2	100 мкФ ЕСАР Электролитический	1	
		C3	10пФ NPO 50B 5% 0805, Керамический	1	
		C4	1500мкФ, ECAP 10B, 105°C, 20%	1	
		C5	2.2пФ NPO 50B, 5%, 0805 Керамический	1	
ıй №		C6	ЕСАР AXIAL (К50-29), 470 мкФ, 63В Электролитический	1	
Справочный №		C7	2.2мкФ X7R 25B 0805 Керамический	1	
		C8	0.1мкФ X7R 10% 1kB 2220 Керамический	1	
		C9	5600пФ X7R 50B 10% 0805 GRM40X7R Керамический	1	
		C10	К78-99 45 мкФ, 250 B, 5% Керамический	1	
ш		C11	0.1 мкФ X7R 10% 250B Керамический	1	
		C12	0.33мкФ Х7R 10% 25В 0805 Керамический	1	
		C13	8200пФ X7R 50В 10% 0805 Керамический		
		C14	ЕСАР AXIAL (К50-29), 470 мкФ, 63В Электролитический	1	
		C15	150пФ NPO 50B 5% 0805 Керамический	1	
цата					
			Диодный мост		
Подпись и		D1, D2	GBJ2510-F, Диодный мост 25A 1000B	2	
Под					
Эπ.			Микросхемы		
Инв. № дубл.		DA1	LD111 "STMICROELECTRONICS"	1	
Инв.		DA2	TNY265 "All POWERINT"		
No		DD1	EPS8266 "Espressif Systems"	1	
Взам. инв. №		DD2	XY-LPWM "Shenzhen Alisi Electronic Technology"	1	
Взам.					
а					
и дата					
Подпись и дата					
Под			ГУИР.565211	.00	1 93
$\vdash$		Изм. Лист Разраб.	№ докум. Подп. Дата Насевич	J	Іит. Лист Листов
подп		Пров.	Мадвейко Модуль преобразователя напряжения		У 1 3
Инв. № подл.		Нач. отд. Н.контр.	Перечень элементов		БГУИР гр.810201
И		Утв.	Перечень элементов		Формат АЛ

	Поз. Обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
		Микросхемы			
	DD3	TCA785HKLA1 "SIEMESNS"	1		
		Реле			
	K1, K2	SRD-05VDC-SL-C "SONGLE"	2		
		Резисторы			
	R1	0.125Вт 0805 10 кОм, 1%	1		
	R2	0.125Вт 0805 3.6 кОм, 1%	1		
	R3	0.125Вт 0805 2 кОм, 5%	1		
	R4	0.125Вт 0805 1 кОм, 1%	1		
	R5	0.062Вт 0402 200 кОм, 1%	1		
	R6	0.125Вт 0805 100 кОм, 5%	1		
	R7	0.125Вт 0805 15 кОм, 5%	1		
	R8	0.125Вт 0805 10 кОм, 5%	1		
	R9	0.125Вт 0805 10 Ом, 1%	1		
	R10	0.250Вт 0805 10 кОм, 5%	1		
	R11	0.250Вт 0805 2 кОм, 5%	1		
	R12, R13	0.25Вт 1206 100 кОм, 5%	2		
-	R14	0.125Вт 0805 1.5 кОм, 5%	1		
	R15	0.125Вт 0805 56 кОм, 1%	1		
	R16	0.125Вт 0805 91 кОм, 1%	1		
	R17	0.125Вт 0805 240 Ом, 1%	1		
	R18	0.125Вт 0805 110 кОм, 1%	1		
	R19	0.125Вт 0805 56 кОм, 5%	1		
	R20-R27	0.125Вт 0805 82 кОм, 1%	6		
	R28	3006P-1-501LF, 500 Ом, Резистор подстроечный	1		
-					
-					
	<del>                                     </del>	<del></del>		Лист	
			ГУИР.565211.001 Э1		
	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Поз. Обозна- чение	Наименова	ание	Кол.	Примечание
	Трансформат	горы		
T1, T2	TI-EE16-1534 "FERYSTER"		2	
Т3	ALT3232M-151-T001 "TDK"		1	
T4	ТПА-20-5в		1	
	Оптроны	I.		
U1, U2	4N25, Оптопара с транзисторным	выходом	2	
	Диоды			
VD1-VD2	1N5819, 1A/25A, 40B		2	Диод Шоттки
VD3-VD10	FR207, 2A, 1000B		8	
VD11-VD13	SB3100, 100B 3A		3	Диод Шоттки
	Транзистор	эы		
VT1	2N7002, 60B, 0.2A		1	
VT2	КТ819А, 40В, 10А, 60Вт, 3МГц		1	
VT3	GT60N321, IGBT 1000V 60A		1	
VT4 – VT5	2SC2785, 40B, 0.1 A		2	
		ГУИР.5652	11 001	л
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	1 <b>У И</b> 1 <b>Г</b> . <b>З О З Z</b>	11.00.	1 91

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

Инв. № подл